

P C T

## 国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

|                                |   |                           |  |
|--------------------------------|---|---------------------------|--|
| 出願人又は代理人<br>の書類記号 TU03-0401W01 | 今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/<br>IPEA/416)を参照すること。 |                           |  |
| 国際出願番号<br>PCT/JPO3/05987       | 国際出願日<br>(日.月.年) 14.05.2003                           | 優先日<br>(日.月.年) 03.12.2002 |  |
| 国際特許分類(IPC) Int. Cl. H01L21/31 |   |                           |  |
| 出願人(氏名又は名称)<br>株式会社日鉱マテリアルズ    |   |                           |  |

|  |
|--|
| 1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。  |
| 2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で 3 ページからなる。<br><input checked="" type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。<br>(PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)<br>この附属書類は、全部で 2 ページである。  |
| 3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。<br>I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎<br>II <input type="checkbox"/> 優先権<br>III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成<br>IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如<br>V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明<br>VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献<br>VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備<br>VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見 |

|   |                              |    |      |
|---|------------------------------|----|------|
| 国際予備審査の請求書を受理した日<br>05.11.2003                                  | 国際予備審査報告を作成した日<br>28.06.2004 |    |      |
| 名称及びあて先<br>日本国特許庁(IPEA/JP)<br>郵便番号100-8915<br>東京都千代田区霞が関三丁目4番3号 | 特許庁審査官(権限のある職員)<br>田代 吉成     | 4R | 9448 |
| 電話番号 03-3581-1101 内線 3470                                       |                              |    |      |

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
PCT規則70.16, 70.17)

☐ 出願時の国際出願書類

☒ 明細書 第 1-8 ページ、出願時に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 請求の範囲 第 2-6, 8, 9 項、出願時に提出されたもの  
請求の範囲 第 1, 7 項、PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☒ 図面 第 1/2-2/2 ページ/図、出願時に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、出願時に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を超えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条（PCT35条(2)）に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

1. 見解

|                 |       |       |   |
|-----------------|-------|-------|---|
| 新規性 (N)         | 請求の範囲 | 1 - 9 | 有 |
|                 | 請求の範囲 |       | 無 |
| 進歩性 (I S)       | 請求の範囲 | 1 - 9 | 有 |
|                 | 請求の範囲 |       | 無 |
| 産業上の利用可能性 (I A) | 請求の範囲 | 1 - 9 | 有 |
|                 | 請求の範囲 |       | 無 |

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

請求の範囲 1 乃至 9 に係る発明が備える構成については、先の国際調査報告において引用した文献に記載もなければその示唆すらなく、また当業者といえども周知・慣用技術に基づき容易に想到しうるものとも認められない。

## 請求の範囲

1. 成長用基板を基板支持具により保持し、有機金属気相成長法により前記成長用基板上に3元素または4元素からなる化合物半導体層を形成するエピタキシャル成長方法において、

基板の有効利用領域全体にわたって、(100)方向からの傾斜角度が0.00°～0.03°、または0.04°～0.10°となるように研磨し、該成長用基板を用いて基板上に前記化合物半導体層を0.5 μm以上の厚さで形成することを特徴とするエピタキシャル成長方法。

2. 前記成長用基板上にバッファ層を形成し、該バッファ層の上に前記化合物半導体層を形成することを特徴とする請求項1に記載のエピタキシャル成長方法。

3. 前記化合物半導体層は、少なくともAsを含むIII-V族系化合物半導体層であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載のエピタキシャル成長方法。

4. 前記化合物半導体層は、InGaAs層あるいはInAlAs層であることを特徴とする請求項3に記載のエピタキシャル成長方法。

5. 前記成長用基板は、転位密度が5.000 cm<sup>-2</sup>以下の半導体結晶基板であることを特徴とする請求項3または請求項4に記載のエピタキシャル成長方法。

6. 前記成長用基板は、InP基板であることを特徴とする請求項5に記載のエピタキシャル成長方法。

7. 有機金属気相成長法により成長用基板上に3元素または4元素からなる化合物半導体層を形成するエピタキシャル成長方法に用いられる成長用基板であって、基板の有効利用領域全体にわたって、(100)方向からの傾斜角度が0.0

$0^{\circ} \sim 0.03^{\circ}$ 、または $0.04^{\circ} \sim 0.10^{\circ}$ であることを特徴とするエピタキシャル成長用基板。

8. 転位密度が $5000 \text{ cm}^{-2}$ 以下の半導体結晶基板であることを特徴とする請求項7に記載のエピタキシャル成長用基板。
9. 前記成長用基板はInP基板であることを特徴とする請求項7または請求項8に記載のエピタキシャル成長用基板。